

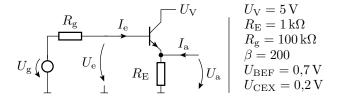
# Einführung in die Elektronik Große Übung 3

G. Kemnitz, C. Giesemann

Institut für Informatik, Technische Universität Clausthal
2. Dezember 2015

## TU Clausthal

#### Aufgabe 3.1



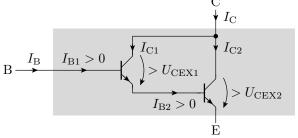
#### Gesucht sind:

- Ersatzschaltung mit dem Transistor im Normalbetrieb.
- Übertragungsfunktionen:  $U_{\rm a} = f\left(U_{\rm e}\right)$  und  $U_{\rm a} = f\left(U_{\rm g}\right)$  für  $I_{\rm a} = 0$
- Spannungsbereich von  $U_{\rm e}$  und  $U_{\rm g}$ , in dem das Modell gültig ist.
- Eingangswiderstand  $R_{\rm e} = \frac{dU_{\rm g}}{dI_{\rm e}}$  für  $I_{\rm a} = 0$
- Ausgangswiderstand  $R_{\rm a} = \frac{d U_{\rm a}}{d I_{\rm a}}$



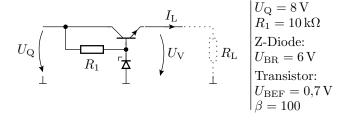
#### Aufgabe 3.2

Die Transistorschaltung in der nachfolgenden Abbildung wird als Darlington-Transistor bezeichnet.



- I Stellen Sie die lineare Ersatzschaltung für den Betriebsfall auf, dass beide Transistoren im Normalbetrieb arbeiten.
- 2 Vereinfachen Sie die lineare Ersatzschaltung soweit, dass sie nur noch aus einer Konstantspannungsquelle und einer stromgesteuerten Stromquelle besteht.

#### Aufgabe 3.3: Längsregler



Bestimmen Sie die linearen Ersatzschaltungen für die Arbeitsbereiche mit dem Transistor im Normalbetrieb und

- 1 der Z-Diode im Durchbruchbereich
- 2 der Z-Diode im Sperrbereich.

Wie verhält sich die Ausgangsspannung in Abhängigkeit vom Laststrom  $I_{\rm L}$  in den Bereichen, in den die Ausgangsspannung und der Laststrom > 0 sind?

#### Aufgabe 3.4: PWM

Für eine pulsbreitenmodulierte Leistungssteuerung mit einem NMOS-Transistor soll gelten:

- Versorgungsspannung:  $U_{\rm V} = 12 \, {\rm V}$
- Lastwiderstand:  $R_{\rm L} = 100 \, \Omega$
- $\blacksquare$  Periode des pulsbreitenmodulierten Signals:  $T_{\rm P}=100\,\mu{\rm s}$
- I Zeichnen Sie die Schaltung aus Schalttransistor und Lastwiderstand.
- 2 Bestimmen Sie die relative Pulsbreite  $\eta$ , die Ein- und die Ausschaltzeit bei dem der Leitungsumsatz  $P_{\rm RL}$  im Lastwiderstand im Mittel 0,2 W beträgt.

### Aufgabe 3.5: CMOS-Gatter

Entwickeln Sie je ein FCMOS-Gatter

11 mit der logischen Funktion:

$$y = \overline{(x_1 x_2) (x_3 \vee x_2)}$$

2 mit der logischen Funktion:

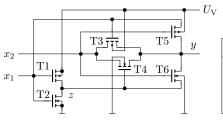
$$y = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee (\overline{x_1 \vee x_2 x_3} \wedge \bar{x}_3)$$

Hinweis: Versuchen Sie zuerst die Gleichungen soweit wie möglich zu vereinfachen.



#### Aufgabe 3.6: Arbeitsbereiche

Bestimmen Sie in der nachfolgenden Transistorschaltung für alle logischen Eingabebelegungen von  $x_1$  und  $x_2$  in welchem Bereich jeder der sechs Transistoren arbeitet und den logischen Ausgabewert von y.



$x_2$	$x_1$	z	T1	T2	T3	T4	T5	T6	y
0	0								
0	1								
1	0								
1	1								

A aktiver Bereich S Sperrbereich  $\mathbf{S}^*$  Sperrbereich, wenn Paralleltransistor ein

Z hochohmig